

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова

Н А К А З

« 19 » 11 2021р.

м. Київ

№ 520 – вк

***Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад наукових працівників***

Відповідно до ч.5 ст. 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 404, постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2021 № 256 «Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи», розпорядження Президії НАН України № 553 від 01.10.2018, розпорядження Президії НАН України № 226 від 20.04.2021р. та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України затвердженого в.о. директором від 16.11.2021р..

Наказую:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад відповідно до Додатку до наказу.
2. Документи на заміщення вакантних посад з візами завідувача відділу та завідувача відділу економічного аналізу та прогнозування науково-дослідних робіт приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу в кім. 225 к.5 вчений секретар Інституту.
3. Завідувачу науково-організаційного відділу забезпечити розміщення інформації про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад на сайті інституту.
4. В.о. вченому секретареві Інституту к.ф.-м.н. Редьку Роману Анатолійовичу та завідувачу відділу наукових кадрів Петрушенко Лілії Євгеніївні забезпечити організаційно-технічне супроводження конкурсу.
5. Відповідальність за проведення конкурсу покласти на в.о. заступника директора з наукової роботи Мамикіна Сергія Васильовича.

В.о. директора Інституту

д.ф.-м.н., професор

Віктор МЕЛЬНИК

**Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України**

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Проведення конкурсу регулюється [ПОРЯДКОМ](#) проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України. Посади та додаткові вимоги до кандидатів, окрім зазначених в [ПОРЯДКУ](#), наводяться в таблиці.

Посада	Додаткові вимоги до кандидатів
У відділ «Теоретичної фізики» (від. № 1)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія);	Ступінь кандидата наук або доктора наук із спеціальностей теоретична фізика чи фізика напівпровідників. Досвід роботи в галузі теоретичної фізики, фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, прикладної фізики. Публікації в журналах кваліфікованих як Q1 та Q2 Досвід участі в проєктах НАН України та міжнародних проєктах. Досвід організаційно-адміністративної роботи.
провідний науковий співробітник (1- вакансія);	Ступень доктора наук із спеціальностей теоретична фізика; Досвід наукової роботи в галузі математичної та теоретичної фізики; Публікації в журналах, кваліфікованих як Q1 та Q2; Досвід участі в міжнародних проєктах; Досвід науково-організаційної роботи.
старшого наукового співробітника (1 - вакансія);	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду та за останні п'ять років не менше п'яти публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Структурного і елементного аналізу матеріалів та систем» (від. № 2)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія);	Науковий ступінь кандидата наук, не менше семи публікацій включених до міжнародних наукометричних баз за останні п'ять років. Бути обізнаним щодо тематики досліджень відділу, а саме: дослідження у галузі рентгенівської діагностики зокрема динамічної теорії дифракції випромінювань, моделювання дифракційних процесів в складних системах. Обізнаність з тематикою та діяльністю відділу протягом останніх 5 років. Віком до 45 років на момент оголошення конкурсу.
наукового співробітника (2 – вакансії);	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Ростових технологій напівпровідникових матеріалів і структур» (від. № 3)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за

	останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Іонно-променевої інженерії» (від. № 4)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Мати науковий ступінь кандидата наук, не менше семи публікацій включених до міжнародних наукометричних баз за останні п'ять років, h-index не нижче 4 Бути обізнаним щодо тематики досліджень відділу, а саме: дослідження у галузі іонно-променевої модифікації та мас спектрометричного аналізу напівпровідникових та нанорозмірних шаруватих структур, технології формування фото приймальних пристроїв для інфрачервоного діапазону спектру Обізнаність з тематикою та діяльністю відділу протягом 5 років Досвід керування іноземними грантами і темами НАН України. Віком до 55 років на момент оголошення конкурсу.
наукового співробітника (2 – вакансії)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
провідного інженера (2 – вакансії)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра.
У відділ «Оптоелектроніки» (від. № 5)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
молодшого наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра
провідного інженера (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра
У відділ «Оптоелектроніки» (від. № 5), лабораторія «Фізико-технічних основ оптоелектроніки» (лаб. № 5.2)	
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів» (від. №6)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Мати науковий ступінь доктора наук та мати досвід керівництва міжнародними та національними науковими проектами Мати не менше 15 річний досвід роботи в області оптичних досліджень напівпровідникових та діелектричних матеріалів
старшого наукового співробітника (1- вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду та за останні п'ять років не менше п'яти публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів

У відділ «Електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників» (від. № 7)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
наукового співробітника у відділ (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики і технології низьковимірних систем» (від. № 8)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Мати ступінь не нижче кандидата наук, досвід роботи у галузі технологічних розробок ІЧ та ТГц фотоелектроніки та низьковимірних структур, фізики електронних процесів у напівпровідникових фото чутливих структурах та досвід керівної роботи у статусі не нижче ніж зав. лабораторії.
провідного наукового співробітника (1-вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук, яка має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні п'ять років не менше семи публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. Бути обізнаним щодо тематики досліджень відділу, а саме; моделювання і дослідження низьковимірних структур на базі вузькощілинних напівпровідникових приймачів для детектування ТГц та ІЧ випромінювання. Мати вчене звання старшого наукового співробітника, h-index не нижче 6, досвід керування іноземними грантами і темами НАН України.
наукового співробітника (3 – вакансії)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
молодшого наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра
У відділ «Фізики і технології низьковимірних систем» (від. № 8), лабораторія «Фотонних напівпровідникових структур» лаб. № 8.1	
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики і технології низьковимірних систем» (від. № 8), лабораторія «Мікросхемотехніки приймачів випромінювання» лаб. № 8.3	
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів

У відділ «Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки» (від. № 9)		
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)		Організаторські здібності, володіння навиками з питань технології колоїдного синтезу напівпровідникових нанокристалів, досвід досліджень поверхневих, електрофізичних та оптичних властивостей нанокристалів $A_2 B_6$, пористих структур (C, TiO ₂ , NiMoO ₄ та «класичних» напівпровідників (Si, Ge, GaAs), розуміння методів конструювання світло випромінюючих пристроїв, сенсорів, датчиків з використанням нанокристалічних матеріалів.
наукового співробітника (1 – вакансія)		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки» (від. № 9), лабораторія «Фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики» (лаб. № 9.1)		
старшого наукового співробітника (1 – вакансія)		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду та за останні п'ять років не менше п'яти публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
наукового співробітника (1 – вакансія)		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки» (від. № 9), лабораторія «Нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії» (лаб. № 9.2)		
наукового співробітника (1 – вакансія)		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки» (від. № 9), лабораторія «Фізики адсорбційних та поверхневих ефектів в напівпровідниках і тонких плівках» (лаб. № 9.3)		
провідного наукового співробітника (1- вакансія)		Володіння методами термодинаміки для розрахунку структурно-фазових перетворень та молекулярної динаміки для розрахунку утворення та кінетики дефектів в напівпровідникових плівках.
У відділ «Фізики оптоелектронних приладів» (від. № 10)		
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)		Досвід роботи по тематиці досліджень відділу фізики оптоелектронних приладів не менше 3 років; Досвід організаторської роботи, не менше 5 років; Віком до 55 років на момент оголошення конкурсу.
провідного наукового співробітника (1 – вакансія)		Особа з науковим ступенем доктора наук, яка має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні п'ять років не менше семи публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
старшого наукового співробітника (2- вакансії)		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду та за останні п'ять років не менше п'яти публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
наукового співробітника у		Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії

відділ (1 – вакансія)	(кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
провідного інженера (1– вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра
У відділ «Фізики і технології нанопровідникових структур та сенсорних систем» (від. № 11)	
наукового співробітника у відділ (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики і технології нанопровідникових структур та сенсорних систем», лабораторія «Напівпровідникових сенсорів УФ- та ІЧ- випромінювання» (від. № 11, лаб. № 11.3)	
завідувача лабораторії (1- вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду та за останні п'ять років не менше п'яти публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Фізики і технології нанопровідникових структур та сенсорних систем», лабораторія «Фізики і техніки сенсорної електроніки» (від. № 11, лаб. № 11.4)	
провідного наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук, яка має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні п'ять років не менше семи публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
наукового співробітника у відділ (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
молодшого наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра
У відділ «Фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства» (від. №12)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. Мати спільні публікації та бути ознайомленим з роботою відділу протягом остання п'яти років.
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Хіміко-технологічний» (від. № 13)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) хімічних наук, яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій

	включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Поляритонної оптоелектроніки та технології наноструктур» (від. № 14)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія);	Досвід роботи в області поляритонної оптоелектроніки, технології наноструктур, поляритонної спектроскопії, плазмоніки (не менше 10 років досвіду); обізнаний з тематикою та діяльністю відділу на протязі останніх 5 років; індекс Хірша не нижче 7; досвід організаційної роботи, досвід оформлення договірної та тендерної документації на придбання матеріалів та обладнання, складання фінансових звітів, кошторисів, табелів, тощо; віком до 60 років на момент оголошення конкурсу
старшого наукового співробітника (1 – вакансія);	Досвід роботи в області поляритонної оптоелектроніки, еліпсометрії, поляритонної еліпсометрії, плазмоніки (не менше 10 років досвіду); обізнаний з тематикою та діяльністю відділу на протязі останніх 5 років; індекс Хірша не нижче 6; досвід оформлення договірної та тендерної документації, складання звітів;
У відділ «Функціональних матеріалів і структур» (від. № 15)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) хімічних наук, яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. Знання основних наукових напрямів роботи відділу Працювати у відділі не менше п'яти років
наукового співробітника (2 – вакансії)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
У відділ «Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки» (від. № 16)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) хімічних наук, яка має не менше п'яти років досвіду за відповідним напрямком діяльності підрозділу, за останні п'ять років не менше 10 публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
наукового співробітника (2 – вакансії)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
У відділ «Інформаційно-комунікаційних технологій» (від. № 57)	
наукового співробітника (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій включених до міжнародних наукометричних баз, та/або

	патентів.
У «Тендерний відділ» (від. № 56)	
провідного фахівця з державних закупівель (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра.
У «Науково-організаційний відділ» (від. № 30)	
заступника завідувача відділу (1 – вакансія)	Особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістра (спеціаліста), яка має не менше п'яти років досвіду, за останні три роки не менше трьох публіка.

Для участі у конкурсі необхідно до 20 грудня 2021 року надіслати поштою або подати особисто на адресу інституту (03028 м. Київ, проспект Науки, 41 ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України в.о вченому секретарю Інституту Редьку Роману Анатолійовичу) такі документи:

1. письмову заяву на ім'я директора про участь у конкурсі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4. автобіографію;
5. копію трудової книжки (за наявності);
6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8. письмову згоду на обробку персональних даних.

• Учасник конкурсу, який є співробітником ІФН ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, надає наступні документи:

1. службову на ім'я Директора від завідувача структурного підрозділу з візою завідувача відділу економічного аналізу та прогнозування науково-дослідних робіт
2. письмову заяву на ім'я Директора про участь у конкурсі, написану власноруч
3. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

- Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.
- Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.
- Строк прийняття заяв та документів не може бути меншим ніж **30 календарних днів** з дня оприлюднення оголошення.
- Протягом **п'яти робочих днів** після закінчення строку подання заяв та документів рішенням Директора затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.
- Для надання роз'яснень звертатися до в.о. вченого секретаря Інституту Редько Романа Анатолійовича, завідувача відділу кадрів Інституту Петрушенко Лілії Євгенівни.

Адреса: пр-т. Науки, 41 м. Київ, 03028, Україна.

Тел.: (044) 525-22-01, (044) 525-64-70.

Адреса електронної пошти sci.sec.redko@gmail.com:

В.о. вчений секретар Інституту фізики НАН України